PAT-NO:

JP405023880A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05023880 A

TITLE:

POSITIONING DEVICE AND LASER BEAM MACHINE

PUBN-DATE:

February 2, 1993

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME IWAMOTO, JOJI YOSHIKAWA, TORU

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

**NIKON CORP** 

N/A

APPL-NO:

JP03176305

APPL-DATE:

July 17, 1991

INT-CL (IPC): B23K026/02, H01L021/82

## ABSTRACT:

PURPOSE: To accurately focus on an object to be measured on a sample and to accurately adjust a position to be worked to a position to be irradiated for a laser machining on the object to be measured without the influence of a thickness, camber, etc., of for example an oxidized film that was formed on the object.

CONSTITUTION: Against a focus reference position that is made the same hight as a fuse on the sample W and is determined from a design data, a focusing deviation value at the measuring position on the scribing line of a block to be worked is detected, a Z stage 8 is activated to focus by a driving means 6 based on the deviation value, and the fuse is two-dimensionally positioned by a moving means 4 while the focused state is maintained.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

## (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-23880

(43)公開日 平成5年(1993)2月2日

(51)Int.CL<sup>5</sup>

識別配号 庁内整理番号

技術

B 2 3 K 26/02

A 7920-4E

技術表示箇所

H01L 21/82

1 /320-4E

9169-4M

H01L 21/82

FΙ

F

## 審査請求 未請求 請求項の数4(全 9 頁)

(21)出願番号

特願平3-176305

(22)出顧日

平成3年(1991)7月17日

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72)発明者 岩本 議治

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式

会社ニコン大井製作所内

(72) 発明者 吉川 透

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式

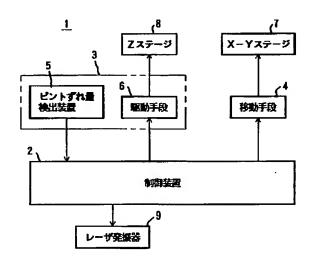
会社ニコン大井製作所内

## (54)【発明の名称】 位置合わせ装置及びレーザ加工装置

#### (57)【要約】

【目的】 試料上の被測定物に対して正確に合焦させる。前記被測定物例えば、その上部に形成された酸化膜等の厚さやそり等の影響なしに被加工位置を照射位置に正確に合わせをしてレーザ加工をする。

【構成】 試料Wのヒューズと同じ高さとなる、設計データから定まる合焦基準位置に対して、加工ブロックのスクライブライン上の測定位置におけるピントずれ量を検知して、このずれ量に基づいて駆動手段6によりZステージ8を動作させて合焦し、合焦状態を維持したままで、移動手段4でヒューズを二次元的に位置合わせするものである。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 設計データで定まる試料の所定位置を光 学系に対して、三次元的に位置合わせする位置制御手段 を有する光学装置において、

前記位置制御手段は、

前記所定位置と同じ高さとなる、設計データから定まる 合焦基準位置を前記光学系に対して合焦する合焦手段

前記合焦手段による合焦状態を維持したままで、前記所 定位置を前記合焦方向に直交する平面内で移動して、前 10 記所定位置を二次元的に位置合わせする移動手段と、 を備えたことを特徴とする位置合わせ装置。

【請求項2】 設計データで定まる試料の被加工位置 を、エネルギービームの照射位置に三次元的に位置合わ せをした後、前記被加工位置に前記エネルギービームを 照射して前記被加工位置を加工するレーザ加工装置にお いて、

試料を該試料の表面を含む平面内で移動させる第1駆動 手段と、

試料を前記平面に直交する方向へ移動させる第2駆動手 20 段と、

前記被加工位置と同じ高さ面となる設計データから定ま る所定位置を、前記照射位置に移動させるべく、前記第 1駆動手段と前記第2駆動手段とを制御する第1制御手 段と、

前記第1制御手段の制御の終了後、前記被加工位置を前 記照射位置に移動させるべく、前記第1駆動手段を制御 する第2制御手段と、

を備えたことを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項3】 前記設計データから定まる所定位置は、 前記被加工位置を含む加工ブロックに隣接したスクライ ブラインであることを特徴とする請求項2記載のレーザ 加工装置。

【請求項4】 設計データで定まる試料の被加工位置 を、エネルギービームの照射位置に三次元的に位置合わ せをした後、前記被加工位置に前記エネルギービームを 照射して前記被加工位置を加工するレーザ加工装置にお いて、

試料を該試料の表面を含む平面内で移動させる第1駆動 手段と、

試料を前記平面に直交する方向へ移動させる第2駆動手 段と、

前記被加工位置と同じ高さ面となる設計データから定ま る複数の所定位置の、前記照射位置からの前記直交する 方向へのずれ量を検出し、該複数のずれ量から前記被加 工位置の前記直交する方向へのずれ量を演算する演算手 段と、

前記被加工位置を前記照射位置に移動させるべく、前記 第1駆動手段を制御する第3制御手段と、

前記ずれ量が零になるように制御する第4制御手段と、 を備えたことを特徴とするレーザ加工装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、位置合わせ装置及び レーザ加工装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体製造装置に用いる位置合わ せ装置は、光源からの光を送光側スリット及びレンズを 介してチップ上に形成されたヒューズに対して斜めに入 射させ、ヒューズの表面で反射した光を、レンズ、傾動 可能のバイブレータ及び受光側スリットを介してディテ クタで受光し、ディテクタの出力に基づいてフォーカス を合わせていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、従来例 では光の反射を利用する装置であるが、ヒューズ上に特 に厚い酸化膜がある場合、入射光はヒューズと酸化膜の 両方で反射し、ヒューズに対して焦点がずれてしまう問 題点があった。この発明の目的は、試料上の被測定物例 えば、上部に酸化膜、特に厚い酸化膜のあるヒューズに 対して、正確に合焦させることができる位置合わせ装置 を提供することである。

【0004】この発明の他の目的は、試料上の被測定物 例えば、その上部に形成された酸化膜等の厚さやそり等 の影響なしに被加工位置を照射位置に正確に合わせてレ ーザ加工が行えるレーザ加工装置を提供することであ る.

[0005]

【課題を解決するための手段】この発明の位置合わせ装 30 置は、設計データで定まる試料の所定位置を光学系に対 して、三次元的に位置合わせする位置制御手段を有する 光学装置に用いるものであり、そのために前記位置制御 手段は、合焦手段と移動手段とを備えている。合焦手段 は、前記所定位置と同じ高さとなる、設計データから定 まる合焦基準位置を前記光学系に対して合焦するもので ある。移動手段は、前記合焦手段による合焦状態を維持 したままで、前記所定位置を前記合焦方向に直交する平 面内で移動して、前記所定位置を二次元的に位置合わせ 40 するものである。

【0006】この発明のレーザ加工装置は、設計データ で定まる試料の被加工位置を、エネルギービームの照射 位置に三次元的に位置合わせをした後、前記被加工位置 に前記エネルギービームを照射して前記被加工位置を加 工するものである。そして被加工位置例えばヒューズと 同じ高さとなる他の場所の所定位置である合焦点を1箇 所または複数箇所測定し、その結果により被測定物の合 焦点を予測して被加工位置に合わせてレーザ加工するも のである。

前記演算手段の演算結果に基づき、前記第2駆動手段を 50 【0007】そのために第1の構成として、第1駆動手

10

段と、第2駆動手段と、第1制御手段と、第2制御手段 とをそれぞれ備えている。第1駆動手段は、試料を該試 料の表面を含む平面内で移動させるものである。第2駆 動手段は、試料を前記平面に直交する方向へ移動させる ものである。第1制御手段は、前記被加工位置と同じ高 さ面となる設計データから定まる所定位置を、前記照射 位置に移動させるべく、前記第1駆動手段と前記第2駆 動手段とを制御するものである。第2制御手段は、前記 第1制御手段の制御の終了後、前記被加工位置を前記照 射位置に移動させるべく、前記第1駆動手段を制御する ものである。

【0008】設計データで定まる試料の被加工位置に は、例えば加工ブロックのヒューズ等が含まれるが、合 焦基準位置として、例えば前記被加工位置を含む加工ブ ロックに隣接したスクライブラインを選択することによ り、その上部に形成された酸化膜等の厚さの影響なし に、オートフォーカスを行える。また第2の構成として は、第1駆動手段と、第2駆動手段と、第3制御手段 と、第4制御手段とをそれぞれ備えている。第1駆動手 段は、試料を該試料の表面を含む平面内で移動させるも 20 のである。第2駆動手段は、試料を前記平面に直交する 方向へ移動させるものである。演算手段は、前記被加工 位置と同じ高さ面となる設計データから定まる複数の所 定位置の、前記照射位置からの前記直交する方向へのず れ量を検出し、該複数のずれ量から前記被加工位置の前 記直交する方向へのずれ量を演算するものである。第3 制御手段は、前記被加工位置を前記照射位置に移動させ るべく、前記第1駆動手段を制御するものである。第4 制御手段は、前記演算手段の演算結果に基づき、前記第 である。

## [0009]

【作用】この発明の位置合わせ装置では、位置合わせに 影響の少ない位置を選択して、合焦して、所定位置例え ばヒューズの合焦点を予測するので、所定位置において 焦点ずれの不具合は解消する。この発明のレーザ加工装 置では、被加工位置例えばヒューズと同じ高さとなる他 の場所の所定位置である合焦点を1箇所または複数箇所 測定し、その結果により被測定物の合焦点を予測して被 加工位置に合わせてレーザ加工するために、正確なオー 40 トフォーカスができて、加工の品質を上げることができ る。

### [0010]

【実施例】この発明に係る位置合わせ装置を図1及び図 2を参照して説明する。本装置は、図1に示す位置制御 手段1を備えている。この位置制御手段は、その本体を 構成している制御装置2、合焦手段3及びX-Yステー ジの移動手段4を備えている。

【0011】制御装置2は、設計データで定まる試料W の所定位置を光学系に対して、三次元的に位置合わせす 50 特に厚い酸化膜のあるヒューズにおいて焦点ずれの不具

るものである。試料Wの所定位置とは、試料W上の加工 ブロックWaの被加工位置となるヒューズの位置であ る。また合焦手段3は、ピントずれ量の検知装置5とZ ステージの駆動手段6とを備えている。ピントずれ量の 検知装置5は、試料W上の加工ブロックWaに隣接して いるスクライブラインWb上の測定位置Aにおけるピン トずれ量を検知するためのものである。ピントずれ量の 検知信号は、制御装置2に送られ、この信号に基づい て、この制御装置によって、Zステージの駆動手段6は 制御される。ピントずれ量の測定値に基づいてZステー ジの駆動手段6の駆動によりZステージ8は所定量だけ 上下動することができ、この上下動により、スクライブ ラインWb上の測定位置Aをヒューズと同じ高さの合焦 基準位置に合焦可能とする。

【0012】X-Yステージの移動手段4は、制御装置 2により制御される。X-Yステージの移動手段4は、 試料Wを載せているX-Yステージ7をX及びY方向に 二次元的に移動させるものである。X-Yステージの移 動手段4は、試料Wの合焦状態を維持したままで、試料 WをXY方向に移動可能である。制御装置2は、レーザ 発振装置9に接続されている。

【0013】次に、設計データにより定まる試料Wのヒ ューズ(被加工位置)を位置合わせする方法を説明す る。まず、X-Yステージ7をX-Yステージの移動手 段4によりAF (オートフォーカス) 座標に移動させ る。そして図2に示すように試料Wの加工ブロックWa に隣接した酸化膜のないスクライブラインWb上の測定 位置Aに光源からの測定光10を入射させ、測定位置A にて反射させて、スクライブライン上におけるピントず 2駆動手段を前記ずれ量が零になるように制御するもの 30 れ量をピントずれ量検知装置5で検知測定して、ピント ずれ量の検知信号に基づいて制御装置2により、ピント ずれ量の測定値に基づいて Zステージの駆動手段6を駆 動させて、2ステージ8を上下動させて、スクライブラ インWb上の測定位置Aを、ヒューズと同じ高さとなる 合焦基準位置(合焦点)に合焦し、合焦した状態を維持 したままで、X-Yステージ7をX-Yステージの移動 手段4によりヒューズ座標に移動させて、試料Wのヒュ ーズの位置合わせを終了する。 その後、位置制御手段 1とは別の制御手段(図示せず。)の制御によりX-Y ステージの移動手段4を駆動させて、X-Yステージ7 上の試料のヒューズを照射位置に移動させ、制御装置2 からの指令に基づいてレーザ発振装置9が作動してレー ザ加工を行う。

> 【0014】このように、ヒューズ以外の酸化膜の薄い 或は無い場所(図示の例ではスクライブラインWb上の 測定位置A)での合焦点を測定することにより、ヒュー ズでの合焦点を予測して、ヒューズに合焦させるもので ある。この例によれば、酸化膜の影響の少ない又は無い 場所の合焦点から、ヒューズの合焦点を予測するので、

合は解消する。

【0015】この発明に係るレーザ加工装置の第1実施 例を図3~図5を参照して説明する。なお、加工に用い る試料Wの構成は図2に示すものと異ならないので、本 例の説明に図2をそのまま使用する。 本レーザ加工装置 は、図3に示すように設計データで定まるX-Yステー ジ15上の試料Wの加工ブロックWaのヒューズ(被加 工位置)を、加工用のレーザ発振装置17から出射され るエネルギービームの照射位置に三次元的に位置合わせ をした後、前記ヒューズに前記エネルギービームを照射 10 して前記ヒューズを加工するものである。

【0016】試料Wのヒューズをエネルギービームの照 射位置に三次元的に位置合わせする装置は、図3に示す ように第1駆動手段11と、第2駆動手段12と、第1 駆動手段及び第2駆動手段12をそれぞれ制御する第1 制御手段13と、第1駆動手段を制御する第2制御手段 14とから構成されている。第1駆動手段11は、図4 に示すようにX-Yステージ15上に載置してある試料 Wをその表面を含む平面内を移動させることができる。 また第2駆動手段12はZステージ16をX-Yステー 20 ジ15上の試料Wをその表面を含む平面と直交する方向 すなわち2方向 (図4上下方向) へ移動させることがで きる.

【0017】第1制御手段13は、設計データで定まる 試料Wのヒューズと同じ高さ面となる設計データで定ま る所定位置に、前記X-Yステージ15及びZステージ 16を移動させる第1駆動手段11及び第2駆動手段1 2を制御するものである。第2制御手段14は、第1制 御手段13の制御の終了後、ヒューズを照射位置に移動 させるために、第1駆動手段11を制御するものであ

【0018】 ヒューズを照射位置に移動させた後は、加 工用のレーザ発振装置17からエネルギビームが出射さ れる。このエネルギービームは、図4に示すようにビー ムエキスパンダ18により拡大された後、ダイクロイッ クミラー19で反射され、対物レンズ20に入射する。 照明光は、反射ミラー21で反射し、エネルギービーム と同軸で試料Wの加工ブロックを照射する。その反射光 は反射ミラー21の上方にあるCCDカメラ22に取込 まれ、加工ブロックWaの加工面の様子がTVモニター 40 23で観察できる。エネルギービームは、X-Yステー ジ15上のエネルギーメータ24で測定され、所定エネ ルギーとなるように第1制御手段13でレーザ励起出力 を調整される。

【0019】次に、レーザ加工方法を主に図5のフロー チャートを参照して説明する。まず、TVモニター23 によりX-Yステージ15上に試料Wの加工ブロックW aがあるか否かを確認する (ステップ:ア)。確認後、 X-Yステージの第1駆動手段11によりAF(オート フォーカス)座標に移動させる(ステップ:イ)。そし 50 クの中心を点対称とする2点である。)の測定位置A,

て加工ブロックWa上に形成された酸化膜のないスクラ イブラインWb上の測定位置Aに光源からの測定光10 を入射させ、スクライブライン上にて反射させて、測定 位置Aにおけるピントずれ量をピントずれ量検知装置で 検知測定する。それにより得られたピントずれ量の検知 信号に基づいて第1制御手段13は、第2駆動手段12 を駆動させて、2ステージ16を上下動させて、測定位 置Aをヒューズと同じ高さ面となる設計データから定ま る所定位置(合焦基準位置)に合わせ、合焦させる (ス テップ:ウ)。そして、TVモニター23によりX-Y ステージ15上の加工ブロックWa内にヒューズがある か否かを確認する (ステップ:エ)。ヒューズがある場 合は、合焦状態を維持したままで、第2制御手段14に より第1駆動手段11を駆動させてX-Yステージ15 を移動させて、加工ブロックWaのヒューズを照射位置 に位置合わせする(ステップ:オ)。その後、第1制御 手段13の制御によるビーム照射指令装置からの指令に 基づいて加工用のレーザ発振器17からエネルギービー ムを出射して、ヒューズにエネルギビームを照射して加 工する(ステップ:カ)。

【0020】このように、加工ヒューズ以外の酸化膜の 薄い或は無い場所(図示の例ではスクライブラインLL の測定位置A)での合焦点を測定することにより、ヒュ ーズでの合焦点を予測し、ヒューズに合焦させて、ヒュ ーズを照射位置に正確に位置合わせし、レーザ加工する するものである。この発明に係るレーザ加工装置の第2 実施例を図6、図7、図8及び図9に基づいて説明す る。

【0021】この例では、図6に示すように傾いている 試料Wの加工ブロックWaをレーザ加工するのに最適で 30 ある。そこで、レーザ加工の際に、ヒューズの正確な位 置合わせをするために、図6に示すように加工ブロック Waの中心を点対称とする任意の2点をA, Bとして、 点Aおよび点Bにおいて合焦となるときのZ軸座標をそ れぞれZa,Zbとすると、加工ブロック中心が合焦す るときのZ軸座標Zは、ZaとZbの平均 {Z=(Za +2b)/2}で求められることに着目した。

【0022】そのために、本例では、図7に示すように 演算手段27と、X-Yステージの第1駆動手段25を 制御する第3制御手段28と、Zステージの第2駆動手 段26を制御する第4制御手段29とを設けている。 す なわち、第1駆動手段25は、X-Yステージ30をX Y方向に二次元的に移動させるものであって、X-Yス テージ上の試料Wをこの試料の表面を含む平面内に移動 させる。また第2駆動手段26は、Zステージ31をZ 方向に移動させることにより、試料Wをこの試料の表面 を含む平面に直交する方向に移動させるものである。 【0023】演算手段27について説明する。図8に示

すように加工ブロックWaの複数(図面では加工ブロッ

Bにおいて、第2駆動手段26を駆動させて設計データ から定まる所定位置(合焦基準位置)のそれぞれに位置 合わせして、測定位置A及び測定位置Bからの所定位置 までの第1ピントずれ量Z1及び第2ピントずれ量Z2 を測定して、両測定値Z1, Z2を演算手段27で演算 して平均値(Z1 + Z2)/2を出すものである。この 演算結果がヒューズの所定位置からのずれ量となる。

【0024】この検算結果に基づいて、第4制御手段2 9はずれ量を零になるように制御している。次に、レー ザ加工方法を主に第9図のフローチャートを参照して説 10 明する。まず、TVモニターによりX-Yステージ30 上に試料Wの加工ブロックWaがあるか否かを確認する (ステップ:ア)。確認後、X-Yステージの第1駆動 手段25により第1AF座標に移動させる(ステップ: イ)。そして図8に示すように加工ブロックWa上に形 成された酸化膜のないスクライブラインWb上の測定位 置Aに光源からの測定光33を入射させ、スクライブラ イン上の測定位置Aにて反射させて、スクライブライン 上における第1ピントずれ量21 をピントずれ量検知装 置で計測する (ステップ:ウ)。同様にして、X-Yス 20 テージの第1駆動手段25により第2AF座標に移動さ せて (ステップ: エ)、スクライブラインWb上の測定 位置Bに測定光33を入射させ、スクライブライン上の 測定位置Bにて反射させて、スクライブライン上におけ る第2ピントずれ量Z2をピントずれ量検知装置で計測 する (ステップ:オ)。そして演算手段27によってピ ントずれ量の演算 (Z1 + Z2 ) / 2を行い (ステッ プ:カ)、この演算結果に基づいてZステージの駆動手 段26を第4制御手段29で制御させて、ずれ量が零に なるまで { (Z1 + Z2) / 2の位置まで} Zステージ 31を上下動させて(ステップ:キ)、合焦基準位置に 合焦する。そしてヒューズの有無を確認してから(ステ ップ:ク)、合焦した状態を維持したままで、X-Yス テージ30を第1駆動手段25によりヒューズ座標に移 動させ (ステップ:ケ)、ビームを照射してレーザ加工 を行う(ステップ:コ)。

【0025】この例によれば、加工ブロックWa上に形 成された酸化膜のないスクライブラインWb上の点A及 び点Bに光源からの測定光33を入射させて、各点の合 焦点を測定することにより、酸化膜の中心すなわちヒュ 40 17 レーザ発振器 一ズの合焦点を予測でき、これによりヒューズの正確な 位置合わせができ、加工の品質を上げることができる。 [0026]

【発明の効果】この発明の位置合わせ装置によれば、試 料上の被測定物例えば、上部に酸化膜、特に厚い酸化膜 のあるヒューズに対して、酸化膜の厚さに影響されるこ となしに正確に合焦させることができる。またこの発明 のレーザ加工装置によれば、試料上の被測定物例えば、 その上部に形成された酸化膜等の厚さやそり等の影響な しに被加工位置を照射位置に正確に合わせてレーザ加工 50 A

を行えて、加工の品質を上げることできる。設計データ で定まる所定位置が被加工位置を含む加工ブロックに隣 接したスクライブラインとすれば、加工ブロック上の酸 化膜に影響されることなく、オートフォーカスができ

## 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の位置合わせ装置の第1実施例を示す ブロック図である。

【図2】試料の一部を示す拡大斜視図である。

【図3】この発明のレーザ加工装置の第1実施例を示す ブロック図である。

【図4】この発明のレーザ加工装置の第1実施例を示す 構成図である。

【図5】この発明のレーザ加工装置の第1実施例による 使用法を示すフローチャートである。

【図6】この発明のレーザ加工装置の第2実施例におけ る加工ブロックと座標軸との関係を示す図である。

【図7】この発明のレーザ加工装置の第2実施例を示す ブロック図である。

【図8】この発明の第2実施例における加工ブロックの 拡大平面図、正面図及び側面図である。

【図9】この発明のレーザ加工装置の第2実施例による 使用法を示すフローチャートである。

#### 【符号の説明】

- 1 位置制御手段
- 2 制御装置
- 3 合焦手段
- 4 移動手段
- 5 ピントずれ量検知装置
- 6 駆動手段
  - 7 X-Yステージ
  - **Zステージ**
  - 10 測定光
  - 11 第1駆動手段
  - 12 第2駆動手段
  - 13 第1制御手段
  - 14 第2制御手段
  - 15 X-Yステージ
  - Zステージ 16
  - - 25 第1駆動手段
    - 26 第2駆動手段
    - 27 演算手段
    - 28 第3制御手段
    - 29 第4制御手段
    - 30 X-Yステージ
    - 31 Zステージ
    - 32 レーザ発振器
    - 33 測定光
- 測定位置

10

. 9

B 測定位置W 試料

Wa 加工ブロック Wb スクライブライン

